



www.hkyq.com.cn

浙江杭可仪器有限公司
浙江省杭州市萧山区鸿达路157号
电话：0571-86451253
传真：0571-82697879
邮箱：atis@hkyq.com.cn

CWBS1000



ATiS[®]



晶圆级可靠性测试系统
Wafer-level reliability test system

ATiS[®]



CWBS1000 1 ZONE

该系统适用于6/8寸晶圆级器件的可控高温的带电可靠性测试，基于JEDEC可靠性测试标准设计；提供高精度高电压输出，保存并且长期记录高精度电流，可控温度等参数，并根据记录测试数据，导出实验表格及MAP图多格式选择。

- 定制化高温调节半自动探针台，支持≤5片晶圆同时老化测试
- 支持每个晶圆Die独立保护功能，对过流过压进行越限控制
- 支持氮气保护防止晶圆氧化，充气时支持过压保护
- 支持更换老化板或探针卡不同封装器件进行测试
- 支持晶圆安装触点到位检测，支持实时温度、压力检测
- 支持HTGB、HTRB等老化测试功能，Vth/I_{ds}/I_{gs}等参数的自动测试和数据分析
- 支持内置晶圆布局MAP配置，数据的实时展示和历史数据的查询
- 支持接入集控站（智慧护芯云）系统，定制化与MES系统对接

CWBS1000 产品特性

试验温区	1(定制支持≤5)
试验温度	室温~200°C
适用产品	GaN/SiC等6寸和8寸晶圆wafer
多工位并行试验	1(定制支持≤5)
温度过冲	<2°C
栅极电压范围(精度)	±60V(0.1%+10mV)
栅极电流范围(精度)	HTGB: 0.1nA-0.1uA (1%±50pA) (单工位) Vth: 100mA (0.1%±20uA) (单工位)
源极电压范围(精度)	2000V (0.5%*V _{max} +1000mV)
源极电流范围(精度)	10nA~800uA (1%±10nA)(单工位)
电压电流过冲	HTRB过冲<2%, HTGB过冲<200mV
通信方式	TCP网络/485串口
操作系统	Windows7及以上系列
MES系统接口	定制对接第三方系统和数据
整机重量	760kg±10%
整机尺寸	2050mm(W)x1400mm(D)x1750mm(H)
单腔体尺寸	1920mm(W)x1250mm(D)x300mm(H)

适用标准

AEC-Q101 JEP183 IEC60749-23 JESD22-A108F

适用器件

适用于GaN/SiC等晶圆wafer的高温、高电压可靠性测试；V_{th}、I_{gs}、I_{ds}等参数功能自动测试和数据分析

CWBS1000

晶圆级可靠性测试系统

Wafer-level reliability test system